POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, INSTYTUT PODSTAW ELEKTROTECHNIKI I ELEKTROTECHNOLOGII

Wzorzec współczynnika strat dielektrycznych

Prof. dr hab. inż. Michał LISOWSKI

W 1968 r. ukończył Wydział Elektryczny Politechniki Wrocławskiej. Stopień doktora n.t. uzyskał w 1975 r., a doktora habilitowanego w 1990, tytuł profesora w 2007. W swoich pracach naukowych zajmuje się problemami wzorcowania przyrządów pomiarowych, systemami pomiarowymi do badania nadprzewodnictwa wysokotemperaturowego, badaniami materiałów elektrotroizolacyjnych, a także normalizacją i prawem technicznym.

e-mail: michal.lisowski@pwr.wroc.pl

Streszczenie

Wzorcowanie mierników pojemności elektrycznej C i współczynnika strat dielektrycznych tg δ jest utrudnione z powodu braku odpowiednio dokładnych wzorców tg δ_n . Wzorzec tg δ_n realizuje się najczęściej poprzez szeregowe połączenie kondensatora z rezystorem o znanej wartości. Główną przyczyną niedokładności takiego wzorca, w zakresie niskich wartości, są parametry resztkowe rezystora. Opisane tutaj oryginalne rozwiązania wzorców tg δ_n przy częstotliwości 50 Hz mają wartości w zakresie (0,1÷10)×10-4 określone z niepewnością 10-5.

Słowa kluczowe: współczynnik stratności dielektrycznej, wzorzec, niskie wartości, niepewność.

Dielectric Dissipation Factor Standard

Abstract

Calibration of electric capacitance C and the $tg\delta$ -factor of meters, used for permittivity and dielectric dissipation factor $tg\delta$ measurements, is difficult as there is no adequately accurate $tg \delta_n$ standards. Dielectric dissipation factor standards are made of series connection of known value capacitor and resistor. Main reason of inaccuracy this type of standard are mainly residual parameters of resistor. In this paper the special construction of the standards $tg\delta_n$ is described and results of testing measurement are gives. The standard tg δ_n has at frequency 50 Hz the range $(0.1 \div 10) \times 10^{-4}$ and uncertainty of value 10⁻⁵.

Keywords: dialectic dissipation factor, standard, low value, uncertainty.

1. Wstęp

Przenikalność elektryczna ε i współczynnik strat dielektrycznych tg δ są podstawowymi parametrami materiałów elektroizolacyjnych. Dla określenia ich wartości badany materiał umieszcza się między elektrodami, które razem z dielektrykiem tworzą stratny kondensator (rys. 1a), i mierzy się jego pojemność C oraz współczynnik strat dielektrycznych tg 8. Po przyłożeniu do elektrod tego kondensatora sinusoidalnie przemiennego napięcia, popłynie przez niego sinusoidalnie przemienny prąd, który wyprzedza napięcie o kąt $\varphi = \pi/2 - \delta$ (rys. 1b).

Stanowi temu można przyporządkować schemat zastępczy równoległego połączenia idealnego kondensatora o pojemności C_r z idealnym rezystorem o rezystancji R_r (rys. 1c) lub szeregowego połączenia idealnego kondensatora o pojemności C_s z idealnym rezystorem o rezystancji R_s (rys. 1d). Obydwa układy są równoważne. Znając parametry jednego układu, na przykład szeregowego, można łatwo przeliczyć je na parametry układu równoległego korzystając z zależności [2]:

$$C_p = \frac{C_s}{1 + \mathrm{tg}\delta} \tag{1}$$

$$R_p = \frac{1 + \mathrm{tg}^2 \delta}{\mathrm{tg}^2 \delta} R_s, \qquad (2)$$

w których

 $\mathrm{tg}\delta = \frac{1}{2\pi f R_{p}C_{p}} = 2\pi f C_{s}R_{s},$ (3)

gdzie f-częstotliwość.



Kondensator stratny (a) i jego wykres wskazowy (b) oraz schematy Rys. 1. zastępcze: równoległy (c) i szeregowy (d)

The loss capacitor (a) and its vectorial graph (b) as well as supplementary Fig. 1. diagrams: parallel (c) and serial (d)

Te uproszczone schematy są ekwiwalentne tylko dla jednej częstotliwości f. Nie odzwierciedlają one zjawisk dyspersji i absorpcji oraz mechanizmów relaksacji dipolowej, a także indukcyjności resztkowych kondensatora i jego doprowadzeń. Ale dla kondensatorów pracujących w obwodach prądu przemiennego niskiej częstotliwości są one praktycznie wystarczające [1]. Chociaż schemat z rys. 1c fizykalnie bardziej poprawnie odpowiada rzeczywistemu kondensatorowi niż z rys. 1d, to ze względu na łatwość modelowania układu, częściej w praktyce stosowany jest schemat zastępczy z rys. 1d.

W zależności od zakresu częstotliwości, pomiary pojemności i współczynnika strat dielektrycznych wykonuje się różnymi metodami i różną aparaturą pomiarową realizującą te metody [1]. W paśmie niskich częstotliwości stosuje się najczęściej mostki czteroramienne, między innymi z gałęzią Wagnera [1, 2, 3], z których najbardziej znany jest mostek Scheringa [3, 4], a także mostki transformatorowe [1, 5]. Obecnie coraz powszechniej używane są przyrządy mikroprocesorowe oparte na pomiarze napięcia i prądu [1, 6] oraz mikroprocesorowe "karty pomiarowe", czyli tak zwane przyrządy wirtualne [7]. Aparatura ta powinna być w odpowiednich odstępach czasu wzorcowana w odniesieniu do wzorców państwowych lub międzynarodowych, tak ażeby umożliwiała wykonywanie pomiarów z odpowiednią niepewnością. Wzorcowanie tych przyrządów na zakresach pojemnościowych nie stwarza większych trudności. Wykonuje się je metodą bezpośrednia, podłączając w miejsce mierzonego kondensatora $C_{\rm r}$ kondensator wzorcowy Cn. Natomiast poważne trudności powstają przy wzorcowaniu tych przyrządów na zakresach tg δ , a to ze względu na problemy realizacji odpowiednio dokładnych wzorców współczynnika strat dielektrycznych tg δ_n .

2. Wzorce współczynnika strat dielektrycznych

Bardzo dokładne wyznaczenie współczynnika strat dielektrycznych rzeczywistego kondensatora można zrealizować pośrednio metodą kalorymetryczną [8, 9], w której współczynnik strat dielektrycznych określa się z zależności:

$$\operatorname{tg}\mathcal{S}_n = W_c / W_b, \qquad (4)$$



gdzie W_c jest energią czynną traconą (rozproszoną) w postaci energii cieplnej podczas przepływu prądu przez stratny kondensator, a W_b jest energią bierną magazynowaną w polu elektrycznym w tym samym czasie, w którym mierzona jest energia czynna tracona w dielektryku. Metoda ta jest jednak trudna w praktycznej realizacji i rzadko stosowana.

Dla pomiarów mniej dokładnych wzorzec współczynnika strat dielektrycznych tworzy się z równolegle (rys. 1c) lub szeregowo (rys. 1d) połączonego bezstratnego kondensatora z rezystorem o pomijalnie małych parametrach resztkowych. Układ równoległy jest trudniejszy do zrealizowania, gdyż wymaga zastosowania bardzo dużych rezystancji i w praktyce najczęściej stosuje się układ szeregowy (rys. 1d). Wartość tg δ_n tego wzorca oblicza się ze wzoru:

$$tg\delta_n = \omega C_n R, \qquad (5)$$

w którym: pulsacja $\omega=2\pi f$, C_n – pojemność wzorcowego kondensatora bezstratnego, R_n - rezystancja rezystora, o pomijalnie małych parametrach resztkowych.

Wzorcom tego typu poświęcona jest obszerna literatura, m.in. [9÷13]. Wzorce o parametrach skupionych odtwarzają w paśmie częstotliwości 50 Hz ÷ 10 kHz wartości wzorcowe tg δ_n w zakresie (5÷1000)×10⁻⁴ z niedokładnością (2÷10) %. Zasadniczą przyczyną ograniczenia dolnego zakresu pomiarowego i dokładności tego typu wzorców są pasożytnicze pojemności sprzęgające.

Guzik i Miczulski zaproponowali oryginalną koncepcję budowy wzorca tg δ_n z wykorzystaniem kondensatora Thomsona-Lamparta [14]. Wymaga on jednak znajomości stratności ciekłego dielektryka, w którym zanurzone są prętowe elektrody kondensatora. Zaletą tego typu wzorca jest możliwość odtwarzania wartości wzorcowej tg δ_n w sposób ciągły.

Innym rozwiązaniem wzorca tg δ_n jest konstrukcja współosiowa wzorca, w której za pomocą współosiowych (koncentrycznych) złącz łączy się szeregowo kondensator wzorcowy z rezystorem, a ekran wykorzystywany jest jako przewód powrotny prądu [13]. Konstrukcja taka minimalizuje indukcyjności resztkowe, mające wpływ na dokładność przy dużych częstotliwościach. Wzorce współosiowe odtwarzają tg δ w paśmie częstotliwości 10 kHz ÷ 100 MHz w przedziale wartości (10 ÷ 1000)×10⁻⁴ z niedokładnością 5 %.

3. Problemy budowy wzorców tg δ_n o parametrach skupionych

Kondensatory i rezystory mają zawsze parametry resztkowe. W zakresie niskich częstotliwości najistotniejszymi z nich są pojemności sprzęgające do masy (rys. 2). Składają się na nie głównie pojemności przepustów doprowadzeń zamocowanych w metalowych ekranach, a więc gniazd złącz koncentrycznych kondensatorów i przepustów zacisków rezystorów.



Rys. 2.Pojemności sprzęgające wzorcowego kondensatora (a) i rezystora (b) oraz
ich szeregowego połączenia (c), C_{k0} – pojemność koncentrycznego kablaFig. 2.The coupling capacity of the standards capacitor (a) and resistor (b) as well
as theirs serial connection (c), C_{k0} - capacity of the concentric cable

Układy do pomiaru pojemności i współczynnika strat dielektrycznych tak się konfiguruje ażeby skrajne pojemności nie miały wpływu na wynik pomiaru. Zatem, jeżeli do układu pomiarowego podłączy się kondensator z rys. 2a, to pojemności sprzęgające do masy C_{10} i C_{20} nie wpływają na wynik pomiaru pojemności C_{12} . Ale jeżeli w szereg (rys. 2c) z tym kondensatorem (rys. 2a) połączy się rezystor (rys. 2b), który ma również swoje pojemności sprzęgające do masy C_{30} i C_{40} , to z wyniku pomiaru można wyeliminować tylko pojemności C_{10} i C_{40} . Do pojemności C_{20} i C_{30} dodaje się jeszcze pojemność łączącego kabla koncentrycznego C_{k0} . Wpływ tych niepożądanych pojemności na wynik pomiaru uwidacznia się szczególnie przy pomiarach małych pojemności i małych współczynników strat dielektrycznych.

Dla kondensatorów wzorcowych podaje się zarówno pojemność C_{12} jak i pojemności C_{10} i C_{20} . Natomiast dla rezystorów pojemności C_{30} i C_{40} na ogół nie są znane, a w przypadku zastosowania rezystora dekadowego, zmieniają się one wraz z nastawą tego rezystora. Można ewentualnie zmierzyć te pojemności i pojemność kabla koncentrycznego C_{k0} , ale ze względu na dużą niestabilność czasową i małe wartości, pomiary te są bardzo utrudnione, a wyniki pomiarów są obarczone bardzo dużymi niepewnościami. Ogranicza to możliwości stworzenia w ten sposób wzorców tg δ_n o wartościach poniżej 5×10⁴. Najskuteczniejszym sposobem jest wyeliminowanie pojemności C_{30} i C_{k0} lub ich minimalizacja do wartości pomijalnie małych.

Problem ten rozwiązano umieszczając rezystor *R* bezpośrednio w koncentrycznym wtyku przyłączonym do gniazda koncentrycznego w kondensatorze (rys. 3a). W ten sposób została prawie całkowicie wyeliminowana pojemność sprzęgająca rezystora C_{30} i pojemność kabla koncentrycznego C_{k0} . Wymaga to jednak przeróbek kabli koncentrycznych.

Innym rozwiązaniem jest umieszczenie rezystora R w specjalnej koncentrycznej złączce kablowej, która ma z jednej strony wtyk koncentryczny podłączony do gniazda kondensatora wzorcowego, a z drugiej strony ma gniazdo koncentryczne podłączone do wtyku koncentrycznego kabla (rys. 3b). To rozwiązanie umożliwia stosowanie firmowych kabli koncentrycznych bez ingerencji w ich złącza.





W ten sposób wykonany wzorzec tg δ_n można przedstawić w postaci schematu pokazanego na rys. 4a. Przekształcając gwiazdę impedancji z rys. 4a w równoważny trójkąt otrzymuje się schemat zastępczy wzorca tg δ_n przedstawiony na rys. 4b.



Rys. 4. Schemat gwiazdowy wzorca tg δ (a) i równoważny mu schemat przekształcenia w trójkąt (b)

Fig. 4. The star diagram of the $tg\delta$ standard (a) and its equivalent diagram of transformation into triangle (b)

Składowa czynna impedancji miedzy punktami 1-4 jest wyrażona zależnością:

$$R' = R \left(1 + \frac{C_{20}}{C_{12}} \right), \tag{6}$$

a wartość wzorcową współczynnika strat dielektrycznych oblicza się ze wzoru:

$$tg\delta_n = 2\pi f R' C_{12}.$$
 (7)

Impedancje Z_{10} i Z_{40} mają charakter pojemnościowy i w odpowiednio skonfigurowanym układzie pomiarowym nie wpływają na wartość wzorca współczynnika strat dielektrycznych.

4. Wyniki testujące

Koncepcję opisanego wzorca tg δ_n przetestowano podczas wzorcowania mostka Scheringa firmy Tettex, typu 2821/ZK, pracującego przy częstotliwości sieciowej 50 Hz i napięciu 1000 V. Wzorce tg δ_n składano, w sposób opisany w rozdziale 3 (rys. 3a), z wzorców pojemności firmy Tettex, typu 3320, o wartościach nominalnych C_1 =100 pF, C_2 =500 pF i C_3 =1000 pF oraz rezystorów o znanych rezystancjach *R*. Kondensatory te miały ważne świadectwa wzorcowania wydane przez Główny Urząd Miar. Rezystancje rezystorów *R* zmierzono przy częstotliwości 50 Hz precyzyjnym mostkiem cyfrowym LCR, typu 1693, firmy Quad Tech, który też miał ważne świadectwo wzorcowania. Wyniki wzorcowania mostka Scheringa na zakresach tg δ podano w tabelach 1÷3.

Oszacowana niepewność rozszerzona bezwzględna wyznaczonej wartości błędu mierzonego współczynnika strat dielektrycznych - określana na poziomie ufności 0.95 - wynosi 1×10^{-5} .

Tab. 1. Wyniki wzorcowania z kondensatorem wzorcowym 100 pF Tab. 1. Results of calibration with the capacitance standard 100 pF

$tg\delta_m$	$tg \delta_n$	$\Delta tg\delta$	$\Delta_{\rm dop}({\rm tg}\delta)$
0,00008	0,00009	-0,00001	$\pm 0,00002$
0,00089	0,00090	-0,00001	±0,00002
0,00234	0,00232	+0,00002	±0,00003
0,00974	0,00967	+0,00007	$\pm 0,00007$
0,02734	0,02720	+0,00014	±0,00016

Tab. 2.Wyniki wzorcowania z kondensatorem wzorcowym 500 pFTab. 2.Results of calibration with the capacitance standard 500 pF

$tg\delta_m$	$tg\delta_n$	$\Delta tg\delta$	$\Delta_{dop}(tg\delta)$
0,00031	0,00032	-0,00001	$\pm 0,00002$
0,00321	0,00325	-0,00004	$\pm 0,00004$
0,00834	0,00840	-0,00006	$\pm 0,00006$
0,03496	0,03501	-0,00005	±0,00019
0,09834	0,09846	-0,00012	±0,00051

Tab. 3.Wyniki wzorcowania z kondensatorem wzorcowym 1000 pFTab. 3.Results of calibration with the capacitance standard 1000 pF

$tg\delta_m$	$tg\delta_n$	$\Delta tg\delta$	$\Delta_{\rm dop}({\rm tg}\delta)$
0,00058	0,00059	-0,00001	$\pm 0,00002$
0,00604	0,00608	-0,00004	±0,00005
0,01572	0,01571	+0,00001	$\pm 0,00010$
0,06571	0,06544	+0,00027	$\pm 0,00035$
0,18498	0,18407	+0,00091	±0,00094

W tabelach 1÷3 oznaczono przez:

- tg δ_m współczynnik strat dielektrycznych zmierzony przez wzorcowany mostek Scheringa,
- tg δ_n wzorcowy współczynnik strat dielektrycznych obliczony ze wzoru (7),
- $\Delta tg\delta$ błąd bezwzględny mierzonego mostkiem współczynnika strat dielektrycznych,
- Δ_{dop}(tgδ) błąd dopuszczalny mierzonego współczynnika strat dielektrycznych, wynikający z błędu granicznego wzorcowanego mostka Scheringa.

5. Wnioski

Opisany wzorzec współczynnika strat dielektrycznych ma przy 50 Hz zakres pomiarowy $(0,1 \div 10) \times 10^{-4}$, a więc poniżej zakresu znanych z literatury wzorców tg δ_n zbudowanych z elementów skupionych RC. Jego niepewność oszacowana na poziomie ufności 0,95 wynosi 10⁻⁵. Umożliwia on wzorcowanie najdokładniejszych mostków do pomiarów pojemności i współczynnika stratności dielektrycznej, na przykład mostka Scheringa pracującego przy częstotliwości sieciowej, który ma rozdzielczość 1×10⁻⁵ i niedokładność w dolnym zakresie pomiarowym 2×10⁻⁵. Badania testujące, wykonane dla mostka Scheringa firmy Tettex, model 2821/ZK, przy użyciu opisanego wzorca tg δ_n wykazały, że wszystkie błędy pomiaru tg δ tego mostka mieszczą w dopuszczalnych granicach, podanych przez producenta. Wcześniej nie udało się tego dowieść przy użyciu wzorców tg δ_n innej konstrukcji. Potwierdza to trafność zaproponowanej koncepcji realizacji wzorca tg δ_n .

Praca zrealizowana w ramach badań statutowych w 2008 r., zlecenie nr 341 701.

6. Literatura

- Lisowski M.: Pomiary rezystywności i przenikalności elektrycznej dielektryków stałych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2004.
- [2] Siciński Z.: Badanie materiałów elektroizolacyjnych. WNT, Warszawa 1968.
- [3] Jellonek A. Karkowski Z.: Miernictwo radiotechniczne. WNT, Warszawa 1972.
- [4] Schwendinger W.: Mostek firmy Tettex typu2821 do pomiarów pojemności i współczynnika stratności tg8 dielektryków stałych i ciekłych. Tettex Information 3002, Febr. 1974.
- [5] Tettex Instruments Heffely Tranch: C & tg delta (power factor) measurement. www.tettex.com.
- [6] Nitsch K.: Zastosowanie spektroskopii impedancyjnej w badaniach materiałów elektronicznych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1999.
- [7] Cichy A., Skórkowski A.: Wirtualny quasi-zrównoważony układ do pomiaru współczynnika strat dielektrycznych. Pomiary Automatyka Kontrola, Vol. 54 (2008), nr 2, s. 48-51.
- [8] Vincentt P.S.: Calorimetric measurement of very low dielectric loss at low temperatures. Brit. J. Appl. Phys., 1969, ser. 2, vol. 2, s. 699-710.
- [9] Guzik J.: Wzorce współczynnika strat dielektrycznych tgô porównanie właściwości. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej 2001, Seria: Elektryka, z. 179, s. 159-169.
- [10] Jellonek A.: Możliwości realizacji wzorców tangensa kąta strat kondensatorów. Rozprawy Elektrotechniczne, tom VII (1961), z. 1, s. 3-16.
- [11]Licznerski B.: Wzorce tangensa strat dielektrycznych o parametrach RC skupionych i rozłożonych. Rozprawy Elektrotechniczne, tom XIV (1968), z. 4, s. 609-627.
- [12] Muciek J.: Wzorce współczynnika strat dielektrycznych kondensatorów – konstrukcja i parametry. Prace Nauk. Inst. Metrologii El. Politechniki Wrocławskiej nr 29, Ser. Konferencje nr 13, Wrocław 1987, s. 78-82.
- [13] Skibiński A.: Kontrolne wzorce współczynnika strat dielektrycznych. Normalizacja 1980, nr 7.
- [14] Guzik J., Miczulski W.: Koncepcja budowy wzorca współczynnika strat tgδ w oparciu o kondensator Thomsona-Lamparta. Materiały Krajowego Kongresu Metrologii, t. 3, Gdańsk 1998, s. 242-249.

Artykuł recenzowany